

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе XI Международной научно-технической конференции «**Микро- и нанотехнологии в электронике**», которая пройдет с **3 по 8 июня 2019 года** в пос. Эльбрус на базе Эльбрусского учебно-научного комплекса Кабардино-Балкарского государственного университета (ЭУНК КБГУ). Оргкомитет желает всем участникам конференции плодотворной работы и приятного отдыха в Приэльбрусье.

Регистрация участников конференции будет проходить 3 июня с 12 до 22 часов и 4 июня с 9 до 11 часов в холле Эльбрусского учебно-научного комплекса КБГУ по адресу пос. Эльбрус, ЭУНК КБГУ.

Продолжительность пленарных докладов до 30 минут. Продолжительность секционных устных докладов 10–15 минут. Объем стендовых докладов не регламентируется. Если у Вас есть пожелания изменить предлагаемую оргкомитетом форму доклада (устный/стендовый), то на месте возможны изменения.

Просим сообщить куда, когда и каким видом транспорта Вы прибываете на конференцию. Наши телефоны есть в информационном сообщении.

Научная программа работы
XI Международной научно-технической конференции
«Микро- и нанотехнологии в электронике»
3–8 июня 2019 г.

3 июня, понедельник

12:00–22:00 Регистрация участников конференции и размещение в гостинице (холл ЭУНК КБГУ, пос. Эльбрус)

13:00 Обед

14:00 Прогулки по окрестностям ЭУНК КБГУ

4 июня, вторник

9:00–11:00 Регистрация участников конференции и размещение в гостинице (холл ЭУНК КБГУ, пос. Эльбрус)

11:00 Открытие конференции (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Вступительное слово: **Альтудов Юрий Камбулатович** – д.т.н., проф., ректор КБГУ, Нальчик

Приветственное слово: **Камилов Ибрагимхан Камилович** – д.ф.-м.н., проф., член кор. РАН, Дагестанский научный центр. РАН, Махачкала

Приветственное слово: **Быков Виктор Александрович** – д.т.н., проф., генеральный директор ЗАО «Нанотехнология МДТ», Президент Нанотехнологического общества России, Москва

Кофе-пауза (холл ЭУНК КБГУ)

11:30 Утреннее заседание (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Пленарная сессия

Председатели: **Камилов Ибрагимхан Камилович** – д.ф.-м.н., проф., член кор. РАН, Дагестанский научный центр. РАН, Махачкала;

Тешев Русла Шахбанович – д.т.н., проф., проф., зав. каф. электроники и информационных технологий, Нальчик

1. Влияние степени упорядочения атомной структуры на свойства полупроводниковых материалов. **Попов А.И.** проф. НИУ МЭИ (Москва)
2. Новый метод исследования динамики решетки: неупругое рассеяние синхротронного излучения. **Вахрушев С.Б.** ГНС ФТИ им. А. Ф. Иоффе., д.ф.-м.н. (Санкт-Петербург).
3. Проводящие протяженные состояния в легированном теллуриде висмута. Годжаев Э.М., Кахраманов К.Ш., **Кахраманов С.Ш.**, Мамедова С.И.
4. Оценка влияния технологических режимов плазменно-искрового спекания керамики на основе карбида кремния на плотность получаемых образцов. **Сафаралиев Г.К.**

5. Газовые сенсоры. Настоящее и будущее. **Гүляев А.М.**, Сарач О.Б. НИУ МЭИ, Москва
6. Фотоэлектрические приемники ИК-излучения 1...4 мкм на основе супрраструктур тяжелых металлов: история разработки. **Мирошникова И.Н.**, Мирошников Б.Н., Зенова Е.В. НИУ МЭИ, Москва
7. Современные информационные технологии в радиоэлектронике на основе теории фракталов, текстур, дробного анализа и методов нелинейной динамики (40 лет научных разработок). **Потапов А.А.** профессор ГНС ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, (Москва).
8. Особенности формирования стабильной нанонеоднородной структуры в стеклах, применяемых в электронике. **Кармоков А.М.**, Молоканов О.А., Шомахов З.В., Молоканова О.О.

Вечернее заседание в 15.00 ч.

Секция 1 Физико-химические свойства материалов и структур микро- и нанoeлектроники

Председатели: **Шебзухов Азамат Аюбович** – д.ф.-м.н., проф., зав. каф. физических основ микро- и нанoeлектроники, Нальчик
Попов Анатолий Игоревич – д.т.н., проф., НИУ МЭИ, Москва

1. Влияние гидростатического давления до 9 ГПа на гальваномагнитные свойства системы Cd_3As_2-MnAs ($MnAs - 20\%$) в поперечном магнитном поле
Сайпулаева Л.А., Абдулвагидов Ш.Б., Гаджиалиев М.М., Алибеков А.Г., Абакарова Н.С., Мельникова Н.В., Захвалинский В.С., Риль А.И., Маренкин С.Ф.
2. Влияние связности каркаса наполнителя на структуру и свойства нанокомполитов полиуретан/углеродные нанотрубки
Атлуханова Л.Б., Козлов Г.В.
3. Оценка возможных изотопных эффектов для кавитационных наноформ углерода
Воропаев С.А., Душенко Н.В., Мартынов Л.Ю.
4. Оптические свойства нанокомполитов – полиэтилен низкой плотности (LDPE) с нанокристаллитами Bi_2Te_3
Абдуллаев Н.А., Гамзаева А.Ю., Ализаде Э.Г., Аждаров Г.Х., Мамедов Н.Т., Алигулиева Х.В., Кахраманов К.Ш.
5. Свойства стекол, защищающих портативные мониторы от разрушения
Старцев Ю.К., Фирсанова Т.В., Тихонова Л.В.
6. Анализ влияния неоднородности поверхности на свойства контакта металл – полупроводник на основе теории сложных систем
Аскеров Ш.Г., Абдуллаева Л.К., Гасанов М.Г., Агамалиева Л.Ф.

7. Влияние степени упорядочения атомной структуры на свойства полупроводниковых материалов
Попов А.И., Воронцов В.А., Попов И.А., Зенова Е. В.
8. Влияние концентрации ацетата кадмия на морфологию и состав фоточувствительных пленок $Cd_xPb_{1-x}S$
Маскаева Л.Н., Мирошников Б.Н., Белов В.С., Ваганова И.В.
9. Спектральные особенности коллоидных квантовых точек в мультимерной структуре
Жуков Н.Д., Роках А.Г., Шишкин М.И.
10. Диэлектрическая проницаемость и проводимость в неоднородных средах
Соцков В.А., Здравомыслова Л.Х.
11. Эффект Купса при поляризации неоднородных веществ
Соцков В.А., Здравомыслова Л.Х.
12. Исследование структурных, электрофизических и оптических свойств наночастиц пористого кремния
Ягудин И.Т., Жуков Н.Д., Терин Д.В.
13. Термоэлектрические свойства твердого раствора $(AgSbTe_2)_{0.8}(PbTe)_{0.2}$
Рагимов С.С., Мусаев М.А., Гашимова Н.Н.
14. Получение и свойства структуры InSe (наночастица) – InSe (кристалл)
Салманов В.М., Гусейнов А.Г., Мамедов Р.М., Рагимов С.С.
15. Влияние элемента цинка на термоэдс $Bi_2Sr_2CaCu_2O_x$
Рагимов С.С., Агаева Г.И.
16. Чувствительность наноструктурированных пленок SnO_2 к газам-окислителям
Перепечина Т.А., Рембеза С.И., Рембеза Е.С., Свистова Т.В.
17. Исследование электронных свойств квантовых точек CdSe/ZnS с помощью сканирующей туннельной микроскопии
Миронюк В.Н., Глуховской Е.Г., Кабанов В.Ф.
18. Изменение термодинамических свойств твердого раствора Si-Ge при изобарическом уменьшении размера нанокристалла
Магомедов М.Н.
19. Инверсия типа проводимости и термоэлектро движущийся сила в твердых растворах $Ce_xSn_{1-x}Se$
Исмаилов Ш.С., Селим-заде Р.И., Абдурахманова В.А., Садыгова А.А.
20. Дефектные центры, снижающие теплопроводность легированного теллурида висмута
Кахраманов К.Ш., Абдуллаев Н.А., Кахраманов С.Ш., Бадалова З.И.
21. Структура и состав тонких пленок сульфида свинца, допированных ионами кадмия и йода
Кутявина А.Д., Маскаева Л.Н., Воронин В.И., Марков В.Ф.

22. Новый метод исследования динамики решетки: неупругое рассеяние синхротронного излучения
Вахрушев С.Б.
23. Свойства квантовых точек InSb, полученных методами коллоидного синтеза и химического травления
Кабанов В.Ф., Михайлов А.И., Гавриков М.В., Крыльский Д.В.
24. Анализ механизма проводимости через квантовую точку InSb методом туннельных ВАХ
Гавриков М.В., Кабанов В.Ф., Михайлов А.И.
25. Анализ температурной зависимости кинетических коэффициентов сплава Bi_{0.94}Sb_{0.06}
Мусаев А.А., Юзбашов Э.Р.
26. Диэлектрические свойства аморфных кремний-углеродных пленок
Баринов А.Д., Гуринович Т.Д., Попов А.И., Шальнева Д.М.
27. Методы и подходы к изучению свойств поверхности оксидных наноматериалов
Екимова И.А., Минакова Т.С., Рустамбек У.
28. Диэлектрические свойства и АС - проводимость керамики Bi_{1-x}Sm_xFeO₃
Алиханов Н.М-Р., Садыков С.А.
29. Исследование свойств фотонных кристаллов на основе пористого оксида алюминия
Кодзасова Т.Л., Аллаяров А.У., Кодзасов В.А., Ширяев А.В., Дедегкаева Л.М., Леонтьева О.Ю.
30. Электрические свойства мемристорного устройства на основе смешанного оксида металлов
Бобылев А.Н., Удовиченко С.Ю., Бусыгин А.Н., Ибрагим А.Х.
31. Размерная зависимость краевых углов смачивания пиролитического графита микрокаплями индия и олова
Сергеев И.Н., Хоконов А.Х., Масаев М.Б., Ахматов З.А., Кумукова Ф.И.
32. Зависимость свойств нанокристалла золота от размера и формы поверхности
Ахмедов Э.Н.
33. Исследование диэлектрических свойств полимерных смесей на основе СКН и ПВХ
Кумыков Т.С.
34. Исследование межзеренного транспорта электронов коллоидных квантовых точек узкозонных полупроводников
Жуков Н.Д., Гавриков М.В., Ягудин И.Т.

35. Исследование спектров фотолюминесценции коллоидных квантовых точек CdSe, PbS, InSb
Хазанов А.А., Крыльский Д.В., Жуков Н.Д.
36. Особенности взаимодействия лазерного излучения и широкозонных полупроводников
Воропаев С.А., Душенко Н.В., Мартынов Л.Ю.
37. Влияние радиационного облучения на релаксорные свойства свойства монокристаллов TlInS_2
Сардарлы Р.М., Матиев А.Х., Наурузов А.А.
38. Край поглощения в монокристаллах $\text{Tl}(\text{GaS}_2)_{1-x}(\text{InSe}_2)_x$ ($x=0\div 0,1$)
Керимова Э.М., Гасанов Н.З., Матиев А.Х., Дакиева И.И.
39. Прыжковая проводимость в монокристаллах TlInS_2
Мустафаева С.Н., Декажесв М.М.
40. К вопросу о кинетике перемещения межфазных границ в процессе контактного плавления с электропереносом
Багов А.М.
41. Влияние отжига на состав и электрофизические свойства поверхности кремния n -типа
Бжыхатлов К.Ч., Люев В.К.

5 июня, среда

Секция 2 Фазовые равновесия и превращения в материалах микро- и нано-электроники

Председатели: **Мирошникова Ирина Николаевна** – д.т.н., проф. директор института НИУ МЭИ, Москва.

Рагимов Садияр Солтан оглы– д.т.н., проф. Институт Физики НАН Азербайджана, Баку

42. Оствальдовское созревание в кристаллах TlGaTe_2
Халилова К.Г., Алиева Н.А., Абдуллаев Н.М.
43. Тепловое оствальдовское созревание эвтектик термоэлектрических систем АВ-NiSb
Абдуллаев Н.А., Азимова С.Р., Алиев О.А., Джафарли К.М., Кахраманов К.Ш., Абдуллаев Н.М.
44. Фазовый переход в условиях ограниченной геометрии
Филимонов А.В., Вахрушев С.Б., Кумзеров Ю.А. Ravi Kumar

45. Особенности измерения температурных зависимостей коэффициентов взаимодиффузии катионов в стеклах при протекающей в них структурной релаксации
Старцев Ю.К.
46. Выбор параметров для расчета изменений свойств стекла после термообработки
Старцев Ю.К.
47. Проводящие протяженные состояния в легированном теллуриде висмута
Кахраманов К.Ш., Годжаев Э.М., Кахраманов С.Ш., Мамедова С.И.
48. Процессы при напылении тонких пленок оксида олова на поверхность стекла сериями сдвоенных лазерных импульсов
Зажогин А.П., Чинь Н.Х., Патапович М.П., Булойчик Ж.И.
49. Синтез нанокластеров оксидов цинка и меди из растворов ортофосфатных солей при лазерной абляции пористых образцов
Зажогин А.П., Чинь Н.Х., Патапович М.П., Булойчик Ж.И.
50. Особенности диффузии фосфора в сильнолегированном галлием германии
Фомин В.М., Кобелева С.П., Анфимов И.М., Юрчук С.Ю., Турутин А.В.
51. Формирование межслоевых нанообъектов в кристаллах р- и n-типа твердых растворов халькогенидов висмута и сурьмы
Кахраманов К.Ш., Абдуллаев Н.А., Кахраманов С.Ш.
52. Формирование твердых растворов системы CdS – PbS методом ионообменного синтеза
Чуфарова Н.А., Уразова К.К., Маскаева Л.Н., Марков В.Ф.
53. К теории фазовых переходов в изинговых магнитных сверхрешеточных нанотрубках
Танрывердиев В.А., Тагиев В.С., Абдуллаев М.Н., Керимова Г.Г., Ибрагимов И.Н.
54. Особенности процесса кристаллизации в биметаллических наноструктурах под внешним давлением
Мясниченко В.С., Сдобняков Н.Ю., Соколов Д.Н., Богданов С.С.
55. Формирование кристаллических фаз в модельных биметаллических кластерах на основе титана
Мясниченко В.С., Сдобняков Н.Ю., Ершов П.М., Акимова Ю.Н., Давыденкова Е.М.
56. Об оценке коэффициента диффузии вблизи раздела металлов при наличии точечных дефектов
Мясниченко В.С., Сдобняков Н.Ю., Колосов А.Ю. Непша Н.И., Щербатых К.Р.
57. Исследование кинетики и механизма образования молекулярного водорода в системе nano-ZrO₂-nano-SiO₂
Меликова С.З., Агаев Т.Н., Велиев Э.Р.

58. Область гомогенности кристаллического три-(8-оксихинолята) индия
Аккузина А.А., Козлова Н.Н., Аветисов Р.И., Аветисов И.Х.
59. Микроструктура спеченной керамики SiC-NbC
Кардашова Г.Д., Шабанов Ш.Ш., Ризаханова С.У.
60. Формирование слоев твердых растворов карбида кремния с нитридом алюминия
Кардашова Г.Д., Гитикчиев М.А., Ахмедов А.С.
61. Формирование микроэлектронных приборных структур с заданными свойствами
Мустафаев М.Г., Мустафаева Д.Г., Мустафаев Г.А.
62. Совершенствование и регулирование технологии изготовления изделий электроники
Мустафаев М.Г., Мустафаева Д.Г., Мустафаев Г.А.
63. Получение, свойства и применение халькогенидов металлов
Мустафаев М.Г., Мустафаева Д.Г., Мустафаев Г.А.
64. Наноструктурированные материалы $\text{Bi}_{1-x}\text{La}_x\text{FeO}_3$ и $\text{Bi}_{1-x}\text{Sm}_x\text{FeO}_3$
Рабданова А.Э., Палчаев Д.К., Гаджимагомедов С.Х., Алиханов Н.М-Р., Эмиров Р.М.
65. Магнитные и структурные особенности сплавов системы $(\text{Sm}, \text{Tb})\text{Fe}_2$
Политова Г.А., Ганин М.А., Михайлова А.Б., Бурханов Г.С.
66. Получение и свойства тонкопленочных резистивных покрытий оксида олова
Сердобинцев А.А., Стародубов А.В., Кожевников И.О., Галушка В.В.
67. Измерение межфазного натяжения микролитровых капель галлия на границе с водой методом капиллярных колебаний
Сергеев И.Н., Хоконов А.Х., Ахматов З.А.
68. Особенности формирования стабильной нанонеоднородной структуры в стеклах, применяемых в электронике
Кармоков А.М., Молоканов О.А., Шомахов З.В., Молоканова О.О.
69. Температурная зависимость краевого угла смачивания свинцом хлоридов калия и натрия с добавками серебра, олова и меди
Дышекова А.Х., Кармоков А.М., Молоканов О.А., Нагоплежева Р.Р., Аброков И.И.
70. Формирование проводящей пленочной матричной структуры на поверхности пироэлектрика ТГС
Хатукаев Х.М., Маремкулов З.А., Кармоков А.М.
71. Влияние структурных и фазовых превращений на термоэлектрические свойства PbTe, допированных CdSe
Калмыков Р.М., Кармоков А.М., Молоканов О.А.

72. Изучение размерной зависимости температуры плавления ниобия при различных давлениях
Крамынин С.П., Ахмедов Э.Н.
73. Влияние добавок Li И Sr на кинетику и фазообразование в сплавах систем Sn-Pb, In-Zn и Sn-Zn, используемых при контактно-реактивной пайке в электронике
Ахкубеков А.А., Ахкубекова С.Н., Багов А.М., Кумукова Т.Ж.
74. Влияние давления на температуру плавления в контакте разрыхленных нанопленок и наночастиц, используемых в электронике
Ахкубеков А.А., Ахкубекова С.Н., Гудиева О.В., Касумов Ю.Н., Созаев В.А.

6 июня, четверг

Секция 3 Технологии наноматериалов и тонкопленочных структур для микро- и наноэлектроники

Председатели: **Рембеза Станислав Иванович** – д.ф.-м.н., проф., Воронежский государственный технический университет, Воронеж
Смирнов Александр Георгиевич – д.т.н., проф. зав. лаб. БГУИР, Минск

75. Халькогениды висмута и сурьмы с межслоевыми наноструктурами и разработка термоэлементов на их основе
Багиров С.Б., Кахраманов С.Ш.
76. Получение и исследование тонких полупроводниковых пленок сульфида индия (III)
Туленин С.С., Баранова К.А., Бунаков В.В., Марков В.Ф.
77. Метод направленной самосборки в литографии проектных норм менее 22 нм
Литаврин М.В., Матюшкин И.В., Гуцин О.П.
78. Полидисперсные частицы меди, полученные с использованием поверхностно-активного вещества
Беглецова Н.Н., Селифонова Е.И., Чернова Р.К., Вениг С.Б., Глуховской Е.Г.
79. Исследования влияния формы канала на процессы образования нанокластеров Aln в плазме при воздействии серий сдвоенных лазерных импульсов на алюминийевую мишень в воздушной атмосфере
Зажогин А.П., Воропай Е.С., Баззал Ходор, Лычковский В.В.
80. Лазерная взрывная литография кремниевых пленок на изолирующих подложках
Сердобинцев А.А., Кожевников И.О., Стародубов А.В., Павлов А.М., Галушка В.В., Рябухо П.В.

81. Исследование кристаллической фазы в пленках аморфного кремния, полученного методом PE CVD на подложках с зародышевым слоем из наночастиц
Абаньшин Н.П., Лазарев С.А., Петров П.В., Хазанов А.А., Цветкова О.Ю.
82. Модификация поверхности графита методом ALD
Растворова И.И., Денисова О.В.
83. Золь-гель синтез тонких пленок оксида цинка с примесью алюминия и исследование их свойств
Белых М.А., Рембеза С.И.
84. Синтез металлооксидных пленок методом спрей-пиролиза
Полковников В.Е., Рембеза С.И., Винокуров А.А.
85. Исследование свойств пленок оксида меди (I) на поверхности ИТО, синтезированных методом электрохимического осаждения
Пермяков Д.С., Рембеза С.И.
86. Влияние γ -излучения на выход водорода при радиолизе гексана на поверхности n-ZrO₂
Агаев Т.Н., Мусаева Ш.З., Иманова Г.Т., Сабзалиев С.А.
87. Оценка влияния технологических режимов плазменно-искрового спекания керамики на основе карбида кремния на плотность получаемых образцов
Кардашова Г.Д., Сафаралиев Г.К.
88. Возможности ионно-плазменных технологий для формирования структуры поверхности металлических имплантов
Смирнов Г.В., Коваль Н.Н., Екимова И.А., Ковальский А.В.
89. Технологические особенности формирования тонких пленок ЦТС на окисленных кремниевых подложках
Каменцев А.С., Петров В.В., Рожко А.А.
90. Мемристивная слоистая структура на основе BiFeO₃/TiO₂(NT)/Ti
Рабданова А.Э., Оруджев Ф.Ф., Гаджимагомедов С.Х., Палчаев Д.К., Рамазанов Ш.М.
91. Плазменная обработка поверхности наноструктурированной керамики YBa₂Cu₃O_{7- γ}
Гаджимагомедов С.Х., Палчаев Д.К., Гаджиев М.Х., Мурлиева Ж.Х., Рагимханов Г.Б.
92. Влияние лазерного излучения на морфологию и десорбционные свойства органических пленок
Туриев А.М., Тваури И.В., Шанаева А.Т.
- 92а. Фотолюминесценция тонких пленок фталоцианинов переходных и редкоземельных металлов
Березов А.В., Валиева Д.Т., Туриев А.М.

93. Свойства фотонных кристаллов на основе анодного оксида алюминия с пористой структурой, заполненной сегнетоэлектриком
Козырев Е.Н., Аскеров Р.О., Мерзлов В.С., Ширяев А.В., Асланов М.А.
94. Исследование многослойных фотонных кристаллов при внедрении в поры оксида алюминия нитрита натрия
Кодзасова Т.Л., Кабулова Т.Р., Кодзасов В.А., Асланов М.А., Собанов В.Х.
95. Изучение методом РФЭС причин деградации защитных пленок, нанесенных на поверхность конструкционной стали
Гогия А.Р., Табухов А.М., Калажоков З.Х., Карамурзов Б.С., Калажоков Х.Х.
96. Применение никрома в качестве катализатора для синтеза углеродных наночастиц
Хамдохов ЗМ., Тешев Р.Ш., Калажоков З.Х., Калажоков Х.Х.

7 июня, пятница

Секция 4. Приборы и устройства; информационные технологии в микро- и нанoeлектронике

- Председатели: **Кармоков Ахмед Мацевич** – д.ф.-м.н., проф., Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
Гуляев Александр Михайлович – д.ф.-м.н., проф., Московский энергетический институт, Москва
97. Обеспечение узловых функциональной устойчивости самовосстанавливающихся деградирующих нанoeлектронных компонентов
Ткаченко К.С.
98. Алгоритм генерации псевдослучайных чисел с помощью клеточных автоматов
Матюшкин И.В., Кожевников В.С.
99. Физико-статистический подход к вопросам надежности наноприборов
Матюшкин И.В., Кожевников В.С.
100. Фотоэлектрические приемники ИК-излучения 1...4 мкм на основе супраструктур тяжелых металлов: история разработки
Мирошникова И.Н., Мирошников Б.Н., Зенова Е.В.
101. Нейросетевые калибраторы для средств измерения и контроля технологических процессов нано- и микроэлектроники
Замятин Н.В., Смирнов Г.В., Маковкин В.И.
102. Особенности формирования промежуточного фотокатода многокамерного ЭОП
Урумов В.В., Козырев Е.Н., Гончаров И.Н., Аскеров Р.О., Кочиев С.М.

103. Вторичная эмиссия в наночастицах и коллоидных квантовых точках анти-монида индия
Мосияш Д.С., Жуков Н.Д.
104. Механизмы накопления заряда в диэлектрических слоях емкостных МЭМС-переключателей
Ткаченко А.В., Лысенко И.Е.
105. Компактная модель диодов Шоттки с ионно-легированными слоями на нитриде галлия
Желаннов А.В., Петров М.Н., Селезнев Б.И., Федоров Д.Г.
106. Разработка технологии изготовления и исследование транзисторов на основе нитрида галлия
Желаннов А.В., Селезнев Б.И., Федоров Д.Г.
107. Стенд для исследования электрофизических параметров тонких пленок ЦТС
Варзарев Ю.Н., Каменцев А.С., Петров В.В.
108. Параметрическая активация микромеханических структур
Ветров А.А., Калёнов В.Е., Корляков А.В., Михайлова О.Н., Сергушичев А.Н.
109. Сравнение частотных характеристик НЕМТ AlGaIn/GaN, изготовленных по 0,25 мкм технологии со сплавными и несплавными омическими контактами
Павлов А.Ю., Павлов В.Ю., Слаповский Д.Н., Клековкин А.В., Майтама М.В.
110. Микроволновый сейсмодатчик
Ширяев А.В., Кодзасова Т.Л., Гугиев Э.Г.
111. Автоматизированное устройство для определения микрокомпонентов жидких сред
Хасцаев Б.Д., Дедегкаева Л.М.
112. Моделирование солнечных элементов в MathCAD
Салказанов А.Т., Датиев К.М.
113. Преобразователь солнечной энергии на основе перовскитов и неорганических полупроводников
Козырев Е.Н., Сабанов В.Х., Гончаров И.Н., Гордеев Г.О., Кучиев Т.Е., Галачиева С.В., Аскеров Р.О.
114. Защита ГИС от электромагнитных излучений
Родионов Ю.А., Мир Д.И., Андрущенко А.О.
115. Анализ параметров датчика Виганда
Родионов Ю.А., Кравчук М.С.
116. Модель автономного малогабаритного имплантируемого устройства для исследований на лабораторных животных
Галушка В.В., Коришунва Г.А., Городков С.Ю., Павлов А.М.

117. Импульсное кодирование цифровой информации в сверхбольших мемристорных кроссбарах для применений во входном блоке нейропроцессора
Писарев А.Д., Бусыгин А.Н., Удовиченко С.Ю.
118. Подход к снижению вероятности ложного срабатывания пассивных оптико-электронных инфракрасных датчиков движения
Волхонский В.В., Малышкин С.Л.
119. КМОП-структура с инверсными карманами
Черкесова Н.В., Блиева А.З.
120. Метод определения жесткости и высоты иглы зондов АСМ методом электросиловой спектроскопии
Бельгушева Л.П., Макаева Л. М.
121. Многочастотный измеритель биоимпеданса на базе микросхемы AD5933
Гуденко Ю.А., Готов А.З., Курданов Х.А., Лосанов Х.Х., Молоканов О.А.
122. Компьютерная измерительная система для снятия вольтамперной характеристики элементов электронных схем
Калмыков Ш.А., Каров Б.Г., Лосанов Х.Х.
123. Сила ван-дер-ваальсова притяжения зонда АСМ к плоской поверхности, покрытой диэлектриком
Канаметов А.А., Мамиков С.Н., Хамурзов А.М., Таппасханова С.Б., Лосанов Х.Х.

Круглый стол: Достижения и перспективы развития микро- и нанотехнологий в электронике.

Награждение победителей конкурса молодых ученых, аспирантов и студентов.

Обсуждение проекта и принятие Решения конференции.

Заккрытие конференции.

8 июня, суббота

Отъезд участников конференции.